

電気学会研究会資料目次

電子デバイス 合同研究会 半導体電力変換

テーマ「パワーデバイス・IC とそのインテリジェント化技術 / 半導体電力変換一般」

- 〔委員長〕和田恭雄（早稲田大学）
〔副委員長〕益 一哉（東京工業大学）
〔幹 事〕本間哲哉（芝浦工業大学），荒川太郎（横浜国立大学）
〔幹事補佐〕大見俊一郎（東京工業大学）
〔委員長〕伊瀬敏史（大阪大学）
〔副委員長〕竹下隆晴（名古屋工業大学）
〔幹 事〕小倉常雄（東芝セミコンダクター社），藤田英明（東京工業大学）
〔幹事補佐〕金井丈雄（東芝三菱電機産業システム），佐藤之彦（千葉大学）

日 時 平成16年10月28日（木） 8：30～18：10
平成16年10月29日（金） 8：30～14：00

場 所 鹿児島大学工学部（鹿児島市郡元1丁目21-40，
<http://www.eng.kagoshima-u.ac.jp/home/maps.html>）

- EDD-04- 48 SOI - RF パワーMOSFET の高周波特性のパターン依存性
SPC-04-110
松本 聡，三野正人（NTT 環境エネルギー研究所）..... 1
- EDD-04- 49 低オン抵抗ハイサイドトレンチ横型パワーMOSFET
SPC-04-111
澤田睦美，岩谷将伸，杉 祥夫，高際和美，
関口 功，松永慎一郎，藤島直人（富士電機アドバンステクノロジー）..... 7
- EDD-04- 50 車載用 LDMOS の ESD サージシミュレーション
SPC-04-112
河野憲司，高橋茂樹，氷見啓明，樋口安史（デンソー）..... 13
- EDD-04- 51 〔欠 番〕
SPC-04-113
- EDD-04- 52 車載用マルチ耐圧（35V/60V/80V）SOI-BiCDMOS
SPC-04-114
江口博臣，川井文彰，大西 徹，神谷宅美，
石間伏寿，中浜和彦，青木宏文，濱田公守（トヨタ自動車）..... 19

EDD-04- 53 SPC-04-115	高機能電源用 IPD (インテリジェントパワーデバイス) の開発 諸田尚彦, 山下哲司, 村田一大, 森 吉弘, 山西雄司 (松下電器産業)	23
EDD-04- 54 SPC-04-116	高精度ゲートドライブを可能にする EPROM 内蔵 600V HVIC プロセス開発 清水和宏, 立宅 聡, 守谷純一 (三菱電機)	29
EDD-04- 55 SPC-04-117	A Breakdown Voltage Improvement in Dielectric Isolation HVIC by using SODI H. Akiyama, T. Terashima, J. Moritani, N. Yasuda (Mitsubishi Electric Corporation)	35
EDD-04- 56 SPC-04-118	SI トランジスタを用いたマルチレベル方式による二次電池電力貯蔵用交直電力 変換器の効率向上 尾崎雄亮, 伊瀬敏史 (大阪大学)	41
EDD-04- 57 SPC-04-119	平滑回路なし変換回路の過負荷保護時における交流フィルタ定数と直流リンク 電圧上昇について 飯盛憲一, 篠原勝次, 竹田 健 (鹿児島大学)	47
EDD-04- 58 SPC-04-120	電気二重層コンデンサにより回生機能を強化した PM モータ用昇圧器付 PWM インバータ 山本吉朗, 篠原勝次, 古川真也 (鹿児島大学)	53
EDD-04- 59 SPC-04-121	双方向絶縁形 DC/DC コンバータの損失分析 井上重徳, 赤木泰文 (東京工業大学)	59
EDD-04- 60 SPC-04-122	高サージ耐量を有する 1200V FS-IGBT モジュール 小野澤勇一, 大月正人, 関 康和 (富士日立パワーセミコンダクタ)	65
EDD-04- 61 SPC-04-123	低熱抵抗・高強度の新絶縁基板を用いた次世代ベースフリー IGBT モジュール の開発 西村芳孝, 望月英司, 菊池昌弘, 西澤龍男, 高橋良和 (富士日立パワーセミコンダクタ)	69
EDD-04- 62 SPC-04-124	ソフトスイッチング用高速 IGBT...SOA の理論と実験 中川明夫, 末代知子, 松田 正, 山口正一, 小倉常雄 (東芝 セミコンダクター社)	73
EDD-04- 63 SPC-04-125	IGBT における二次破壊シミュレーション (II) 高田育紀 (三菱電機)	79
EDD-04- 64 SPC-04-126	高短絡耐量を有する HV 用 IGBT の開発	

河路佐智子，杉山隆英，庄司智幸，石子雅康（豊田中央研究所）
堀田幸司、深見武志，濱田公守（トヨタ自動車）..... 85

EDD-04- 65 1200V 逆阻止 IGBT の電気的特性
SPC-04-127

内藤達也，武井 学，根本道生，
林 崇，上野勝典（富士電機アドバンステクノロジー）..... 91

共 催 IEEE Industrial Electronics Society (IES) Japan Chapter
IEEE Power Electronics Society (PELS) Japan Chapter
IEEE Industry Applications Society (IAS) Japan Chapter

電気学会研究会資料目次

電子デバイス 合同研究会 半導体電力変換

テーマ「パワーデバイス・IC とそのインテリジェント化技術 / 半導体電力変換一般」

- EDD-04- 66 サブミクロンの浅いベース構造を有する DC-DC コンバータ向け 30V 系
SPC-04-128 プレーナ MOSFET
小野昇太郎, 山口好広, 川口雄介, 中川明夫 (東芝 セミコンダクター社) 1
- EDD-04- 67 SiC 二重エピ成長技術を用いた縦型 MOSFET の低オン抵抗化
SPC-04-129
原田信介, 岡本光央, 八尾 勉,
安達和広, 福田憲司, 荒井和雄 (産業技術総合研究所) 5
- EDD-04- 68 高出力ノーマリオフ AlGaIn/GaN HFET
SPC-04-130
池田成明, 李 江, 吉田清輝 (古河電工) 11
- EDD-04- 69 低オン電圧動作 GaN-FESBD
SPC-04-131
吉田清輝, 李 江, 池田成明, 和田崇宏, 竹原洋斉 (古河電工) 17
- EDD-04- 70 トレンチ埋め込みエピを用いた耐圧 200V 系スーパージャンクション MOSFET
SPC-04-132
服部佳晋, 中島京子, 桑原 誠, 吉田友幸 (豊田中央研究所)
山内庄一, 山口 仁 (デンソー) 23
- EDD-04- 71 20m cm²-600V クラス Superjunction MOSFET
SPC-04-133
齋藤 渉, 大村一郎, 相田 聡,
上月繁雄, 泉沢 優, 吉岡裕典, 小倉常雄 (東芝) 27
- EDD-04- 72 マルチイオン注入法で形成した 60-100V Superjunction UMOSFET
SPC-04-134
二宮 仁, 三浦喜直, 小林研也 (NEC エレクトロニクス) 31

EDD-04- 73 pin ダイオードおよびスーパージャンクションダイオードにおける順方向過渡特性
SPC-04-135

山崎みや，小林秀雄，篠原信一（オリジン電気）..... 37

共 催 IEEE Industrial Electronics Society (IES) Japan Chapter
IEEE Power Electronics Society (PELS) Japan Chapter
IEEE Industry Applications Society (IAS) Japan Chapter